









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB025N08N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB025N08N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB025N08N3 G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 23844 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB025N08N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB025N08N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23844 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14200pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB025N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB025N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB025N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB025N08N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB024N08N5 INFINEON IPB024N08N5 INFINEON</p>	 <p>IPB023N06N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 140A TO263-7</p>	 <p>IPB025N10N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB023N06N3G INF IPB023N06N3G INF</p>
 <p>IPB025N10N3G INFINEO IPB025N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB025N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB024N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB024N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB025N08N3 G International Rectifier	IPB025N08N3 G Datenblatt	IPB025N08N3 G-Datenblätter	IPB025N08N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB025N08N3 G
IPB025N08N3 G Electronic	IPB025N08N3 G-Komponenten	IPB025N08N3 G-Verteiler	IPB025N08N3 G-Bild	IPB025N08N3 G-Teil
IPB025N08N3 G Preis	IPB025N08N3 G Hersteller	IPB025N08N3 G Bild	IPB025N08N3 G Aktie	IPB025N08N3 G Inventar
IPB025N08N3 G Neu	IPB025N08N3 G Original	IPB025N08N3 G garantiert	IPB025N08N3 G RFQ	IPB025N08N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited